

Характеристики наборов биполярных транзисторов

$ h_{21E} $	Модуль коэф. пер. тока на выс. част.	I_{CBO}	Обратный ток коллектора
$ U_{вe1}-U_{вe2} $	Модуль разн. прямых напр. база-эм.	I_{EBO}	Обратный ток эмиттера
$\Delta U_{вe1}-U_{вe2} $	Абс. изм. мод. разн. напр. база-эм.	I_{CBS}	Начальный ток коллектора
$U_{вe}$	Прямое падение напр. база-эм. тр.	$I_{кэ}$	Обратный ток коллектора-эмиттера
C_c	Емкость коллекторного перехода	$I_{Т1Т2 0}$	Ток утечки между транзисторами
C_e	Емкость эмиттерного перехода	h_{21E}	Стат. коэф. прямой передачи тока в схеме с общим эм. в режиме бол. сиг.
h_{21E}/h_{21E2}	Отн. стат. коэф. прямой передачи тока в схеме с общим эм. в режиме большего сигнала		

Тип	Параметр												Тип корпуса	Тех. условия	Аналог	Функционал. назн-е	Диапазон рабочих температур, °С	Количество транзисторов	
	$I_{CBO}, \text{нА}$	$I_{EBO}, \text{нА}$	$I_{CBS}, \text{нА}$	$I_{кэ}, \text{нА}$	$I_{Т1Т2 0}, \text{нА}$	h_{21E}	h_{21E}/h_{21E2}	$ h_{21E} $	$ U_{вe1}-U_{вe2} , \text{мВ}$	$\Delta U_{вe1}-U_{вe2} , \text{мВ}$	$U_{вe}$	$C_c, \text{пФ}$							$C_e, \text{пФ}$
129НТ1АН1	20	50	50	-	10	30;90	0,9	2,5	<3	<2	0,55;0,75	3	4	б/к	АЕЯР.431410.464ТУ	SA2713	Базовая схема дифференциального усилителя	-60 -; +125	2
129НТ1БН1						60;180		3,5											
129НТ1ВН1						>80		0,92											
129НТ1ГН1						30;90	0,8	2,5	<10	<6									
129НТ1ДН1						60;180													
129НТ1ЕН1						>80													
129НТ1ЖН1						40;160													
129НТ1ИН1						40;160	0,8	<10	<6										
159НТ1А	10	30	-	30	10	30;90	0,9	<3	<2	0,55;0,75	3	4	3101.8-9.01	АЕЯР.431410.455ТУ	SA2713	Базовая схема дифференциального усилителя	-60 -; +125	2	
159НТ1Б						60;180													
159НТ1В						>80													0,92
159НТ1Г						30;90	0,8	2,5	<10										<6
159НТ1Д						60;180													
159НТ1Е						>80													
159НТ101А						30;90													
159НТ101Б						60;180													
159НТ101В						>80	0,92												
159НТ101Г						30;90	0,8	2,5	<10										<6
159НТ101Д	60;180																		
159НТ101Е	>80																		